# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-317033

(43)Date of publication of application: 31.10.2002

(51)Int.CI.

C08G 61/00 C09K 11/06

H05B 33/14 H05B 33/22

(21)Application number: 2001-121199

1199 (71)

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

19.04.2001

(72)Inventor: ARAKI KATSUMI

# (54) NEW POLYMER, LIGHT-EMITTING ELEMENT MATERIAL, AND LIGHT-EMITTING ELEMENT UTILIZING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer having high carrier injecting properties, transportability, emission luminance, luminous efficiency and color purity in an electroluminescent element. SOLUTION: The new polymer is represented by formula (I) (wherein, R denotes a ≥7C alkyl group; (n) denotes a number of ≥5; R2 denotes a substituent group; a's denote each independently a number of 0−3; and Cb denotes an aromatic hydrocarbon group).

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2002-317033 (P2002-317033A) (43)公開日 平成14年10月31日(2002.10.31)

(51) Int. C1. <sup>7</sup> C 0 8 G C 0 9 K H 0 5 B	識別記号 61/00 11/06 680 33/14 33/22	FI デーマコート* (参考) C 0 8 G 61/00 3K007 C 0 9 K 11/06 6 8 0 4J032 H 0 5 B 33/14 B 33/22 B D
	審査請求 未請求 請求項の数4 0]	
(21) 出願番号	特願2001-121199 (P2001-121199)平成13年4月19日 (2001. 4. 19)	(71) 出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72) 発明者 荒木 勝己 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内 (74) 代理人 100105647 弁理士 小栗 昌平 (外4名) Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB11 AB18 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00 4J032 BA12 BB06 BB09 BC02 CA04 CA12 CB12 CD00 CG00

(54) 【発明の名称】新規重合体、それを利用した発光素子材料および発光素子

## (57) 【要約】

【課題】電界発光素子においてキャリア注入性、輸送 性、発光輝度、発光効率、色純度の高い重合体を提供す る。

【解決手段】下記一般式(1)で表される重合体、該重 合体である発光素子材料及び該重合体を含有する発光素 子。

# 【化1】

(式中、Rは炭素数7以上のアルキル基を、nは5以上 の数を、R<sup>2</sup>は置換基を、aは独立に0から3までの数 を表す。СЬは芳香族炭化水素基を表す。)

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(1)で表される重合体。

## 【化1】

\*(一般式(I)中、Rは炭素数7以上20以下のアルキ ル基を、nは5以上の数を、R<sup>2</sup>は置換基を、aは独立 に0から3までの数を表す。Cbは芳香族炭化水素基を 表す。)

【請求項2】下記一般式(11)で表される重合体。 【化2】

※(一般式(III)中、Rは炭素数7以上20以下のアル

b は芳香族炭化水素基を表す。)

【化4】

キル基を、R<sup>2</sup>は置換基を、R<sup>4</sup> はアルキル基を、nは

5以上の数を、aは独立に0から3までの数を表す。C

$$A_{I} = \begin{bmatrix} R_{1} & R_{1} & & & \\ R_{1} & R_{1} & & & \\ R_{2} & & & \\ R_{2} & & & \\ R_{3} & & & \\ R_$$

(式中、nは5以上の数を、R1、R2、R3は各々置換 基を、aは独立に0から3までの数を表す。bは独立に 0から2までの数を表す。Arは上記の基を表す。Cb は芳香族炭化水素基を表す。)

【請求項3】下記一般式(III)または(IV)で表され る重合体であることを特徴とする発光素子材料。

#### 【化3】

(一般式(IV)中、nは5以上の数を、aは独立に0か ら3までの数を表す。R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は各々置換基を表 す。bは独立に0から2までの数を表す。Arは上記の 基を表す。Cbは芳香族炭化水素基を表す。Hetはヘ テロ芳香族環を表す。)

【請求項4】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含 50 【0001】

む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、少 なくとも一層が請求項3記載の一般式(111)または(1 V) で表される重合体を含有する事を特徴とする発光素 子。

#### 【発明の詳細な説明】

3

【発明の属する技術分野】本発明は、高いキャリア注入性、キャリア輸送性を有する重合体、半導体素子用材料、それを利用した半導体素子、電気エネルギーを光に変換して発光できる有機電界発光素子(以下、発光素子と称する)用材料および発光素子に関し、電子回路、トランジスタや表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信デバイス等の分野に好適に使用できる発光素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発が活発であり、なかでも発光素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができるため、将来有望な表示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸着により有機薄膜が積層された発光素子(積層型素子)(アプライド フィジックス レターズ、51巻、913頁、1987年)や、ポリマー系素子(Nature、Vol.356、5 Marchl992、47項)が知られている。

【0003】なかでもポリマー系材料による塗布型素子の作成は、製造プロセスが簡便であるため、これまで種々の検討がなされてきた。例えば、ポリフルオレン共重合体の重合方法は、米国特許、第5,777,070号等に、ポリフルオレン共重合体およびこれを使用した素子は、WO97/33323号、同97/05184号、同99/48160号、同99/54385号、アプライドフィジックスレターズ,75巻,3270頁,1999年等に開示されているとおりだが、更なる駆動電圧の低下、キャリア移動度の向上、発光効率の向上が望まれていた。またポリマー系発光材料を使用する場合、素子作成直後あるいは駆動または経時により、ポリマー鎖間の相互作用によってエキサイマーが形成され、発光波長が溶液状態より長波化するという問題が生

じる場合があった。

【0004】また長時間経時後に駆動した場合や連続駆動時に、輝度の低下が起きやすいなど耐久性でも問題があり、ポリマー系素子は実用に供するには多くの問題を抱えていた。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、製造工程、加工性、大面積化に有利なポリマー系材料を使用した場合の上記の問題を解決するべく、低電圧駆動、高輝度、高発光効率の特性を有し、かつ高温保存耐久性を有する新規な発光素子の提供にある。また電子デバイス材料として、ホールまたは電子を高い移動度で注入・輸送し、膜作成が簡便な材料を提供する事にある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記課題は下記の本発明 の手段により達成された。

(1)下記一般式(I)で表される重合体。

[0007]

【化5】

20

【0008】(一般式(I)中、Rは炭素数7以上のアルキル基を、nは5以上の数を、R2は置換基を、aは独立に0から3までの数を表す。Cbは芳香族炭化水素基を表す。)

30 (2)下記一般式(II)で表される重合体。

[0009]

【化6】

$$Cb \xrightarrow{R^1 R^1} A_I \xrightarrow{Cb} Cb$$

$$-\underline{R} \not\equiv (II)$$

$$A_I = \xrightarrow{R^3 b} (R^3)b \xrightarrow{N-N} (R^3)b$$

$$N = (R^3)b \xrightarrow{R^3 b} (R^3)b$$

【0010】(式中、nは5以上の数を、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は各々置換基を、aは独立に0から3までの数を表す。bは独立に0から2までの数を表す。Arは上記の基を表す。Cbは芳香族炭化水素基を表す。)

(3) 下記一般式(III) または(IV) で表される重合体であることを特徴とする発光素子材料。

【0011】 【化7】

アルキル基を、R<sup>2</sup>は置換基を、R<sup>4</sup> はアルキル基を、 nは5以上の数を、aは独立に0から3までの数を表

一般式 (皿)

【0014】(一般式(IV)中、nは5以上の数を、a は独立に 0 から 3 までの数を表す。 R¹、R²、R³は各 々置換基を表す。bは独立に0から2までの数を表す。 Arは上記の基を表す。Cbは芳香族炭化水素基を表 す。Hetはヘテロ芳香族環を表す。)

(4) 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 の有機化合物層を形成した発光素子において、少なくと も一層が(3)に記載の発光素子材料を含有する事を特 徴とする発光素子。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。なお、本明細書において「~」はその前後に記載 される数値を、それぞれ最小値および最大値として含む 範囲を示す。

【0016】上述の様に、低電圧駆動、高輝度、高発光 効率の特性を有し、かつ高温保存耐久性を有する材料を 開発するため、本発明者は鋭意検討を重ねた結果、上記 一般式(I)~(IV)に示されるような共重合成分を有 するポリフルオレン共重合体を開発するに至った。ポリ フルオレン共重合体およびその重合方法およびこれを使 用した素子等は、上述の米国特許、第5,777,07 0号、WO97/33323号、同97/05184 号、同99/48160号、同99/54385号、ア 40 プライド フィジックス レターズ、75巻、3270 頁、1999年等で既に報告されている通りだが、上記 (1)および(2)に示されるような共重合成分を有す るポリフルオレン共重合体はこれまで全く報告されてい なかった。また、アプライドフィジックス レターズ, 75巻, 3270頁, 1999年には、2, 5-ジデシ ルオキシ基を有する本発明の類似化合物が報告されてお り、種々の層構成のデバイスが検討されているが、フィ ルムでの発光波長420 nmおよび448 nm、半値幅

が高く低輝度であった。

【0017】次に本発明の一般式(1)の化合物につい て詳細に説明する。式中、Rとしては、それぞれ独立 に、炭素数7から20までのアルキル基が好ましく、フ ルオレン環の9位炭素原子と結合し炭素数7から20の 環構造を形成しても良い。Rとして、炭素数8から16 までのアルキル基がより好ましく、ノルマルオクチル 基、2-エチルヘキシル基、ノルマルデシル基、ノルマ ルドデシル基、ノルマルヘキサデシル基、が特に好まし

【0018】R<sup>2</sup>としては、それぞれ独立に、炭素数1 から20までのアルキル基、炭素数1から20までのア ルキルオキシ基、炭素数 1 から 2 0 までのチオエーテル 基、炭素数1から20までのアルキルカルボニルオキシ 基またはシアノ基が好ましく、炭素数1から16までの アルキル基、炭素数1から16までのアルキルオキシ 基、炭素数1から16までのチオエーテル基、炭素数1 から16までのアルキルカルポニルオキシ基またはシア ノ基がより好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプ ロピル基、イソプロピル基、ノルマルブチル基、イソブ チル基、ターシャリーブチル基、ノルマルヘキシル基、 ノルマルオクチル基、2-エチルヘキシル基、ノルマル ドデシル基、ノルマルヘキサデシル基、メトキシ基、エ トキシ基、ノルマルプロピルオキシ基、イソプロビルオ キシ基、ノルマルブチルオキシ基、イソブチルオキシ 基、ノルマルヘキシルオキシ基、ノルマルオクチルオキ シ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノルマルドデシル オキシ基、ノルマルヘキサデシルオキシ基、メチルチオ 基、エチルチオ基、ノルマルプロピルチオ基、イソプロ ピルチオ基、ノルマルブチルチオ基、イソブチルチオ 基、ノルマルヘキシルチオ基、ノルマルオクチルチオ 基、2-エチルヘキシルチオ基、ノルマルドデシルチオ 69 nmと依然発光波長は長く、素子性能でも駆動電圧 50 基、ノルマルヘキサデシルチオ基、メチルカルボニルオ

キシ基、エチルカルボニルオキシ基、ノルマルプロピルカルボニルオキシ基、イソプロピルカルボニルオキシ基、ノルマルブチルカルボニルオキシ基、イソブチルカルボニルオキシ基、ノルマルベキシルカルボニルオキシ基、ノルマルオクチルカルボニルオキシ基、ノルマルドデシルカルボニルオキシ基、ノルマルトデシルカルボニルオキシ基、ノルマルトデシルカルボニルオキシ基、シアノ基が特に好ましい。

【0019】ポリマーの重合度nとしては、5~10000が好ましく、10~10000がおり好ましく、20~10000が特に好ましい。

【0020】aとしては、 $0\sim2$ が好ましく、 $0\sim1$ がより好ましく、0が特に好ましい。

【0021】Cbとしてはペンゼン環、ナフタレン環、 フェナンスレン環が好ましく、これ等の環は更に置換基 を有していても良い、置換基としては、アルキル基、ア リール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アラルキ ルオキシ基、アルキルチオ基、ニトロ基、トリフルオロ メチル基、カルポキシル基、ホルミル基、アルコキシカ ルポニル基、アシル基、アルケニル基、ジアルキルアミ ノ基が好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロピ ル基、イソプロピル基、ノルマルプチル基、ターシャリ ーブチル基、シクロプロピル基、フェニル基、メトキシ 基、エトキシ基、ノルマルプロポキシ基、イソプロポキ シ基、フェニルオキシ基、ペンジルオキシ基、メチルチ オ基、エチルチオ基、ノルマルプロピルチオ基、イソプ ロピルチオ基、ノルマルブチルチオ基、ニトロ基、トリ フルオロメチル基、カルボキシル基、ホルミル基、メト キシカルポニル基、エトキシカルポニル基、ノルマルプ ロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、 メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、ノルマルプ ロピルカルボニル基、イソプロピルカルボニル基、ノル マルプチルカルボニル基、ビニル基、ジメチルアミノ基 がより好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロピ ル基、ターシャリープチル基、シクロプロピル基、フェ ニル基、メトキシ基、エトキシ基、フェニルオキシ基、 ベンジルオキシ基、メチルチオ基、ニトロ基、トリフル オロメチル基、カルポキシル基、ホルミル基、メトキシ カルボニル基、エトキシカルボニル基、メチルカルボニ ル基、ビニル基、ジメチルアミノ基が特に好ましい。

【0022】次に本発明の一般式(II)の化合物について詳細に説明する。R<sup>1</sup>としては、それぞれ独立に、炭素数1から20までのアルキル基、一つ以上の硫黄原子、窒素原子、酸素原子または珪素原子を含有する炭素数1から20までのアルキル基、炭素数4から16までのアルキルカルボニルオキシ基、炭素数6から16までのアリール基が好ましく、フルオレン環の9位炭素原子と結合して環を形成してもよく、形成される環として好ましくは、炭素数5から20の環構造、あるいは硫黄原子、窒素原子または酸素原子を含有する炭素数4から2

0の環構造のものである。R1として、炭素数1から1 6までのアルキル基、炭素数1から16までのポリアル キレンオキシ基、炭素数4から8までのアルキルカルボ ニルオキシ基、炭素数6から14までのアリール基がよ り好ましく、炭素数8から16までのアルキル基が更に 好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロビル基、 イソプロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、ノ ルマルヘキシル基、ノルマルオクチル基、2-エチルヘ キシル基、ノルマルドデシル基、ノルマルヘキサデシル 10 基、メトキシエトキシエチル基、エトキシエトキシエチ ル基、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオ キシ基、ノルマルプロピルカルボニルオキシ基、イソプ ロピルカルボニルオキシ基、ノルマルブチルカルボニル オキシ基、イソブチルカルポニルオキシ基、ノルマルへ キシルカルボニルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、 アンスリル基が更に好ましく、ノルマルヘキシル基、ノ ルマルオクチル基、2-エチルヘキシル基、ノルマルド デシル基、ノルマルヘキサデシル基が特に好ましい。

【0023】 $R^2$ 、a、nとしては、-般式(I) で述 20 べたのと同様の基がそれぞれ好ましい範囲として選択される。

【0024】R<sup>3</sup>としては、アルキル基、アリール基、 アルコキシ基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ 基、アルキルチオ基、ニトロ基、トリフルオロメチル 基、ジアルキルアミノ基が好ましく、メチル基、エチル 基、ノルマルプロピル基、イソプロピル基、ノルマルブ チル基、ターシャリーブチル基、シクロプロピル基、フ ェニル基、メトキシ基、エトキシ基、ノルマルプロポキ シ基、イソプロポキシ基、フェニルオキシ基、ベンジル 30 オキシ基、メチルチオ基、エチルチオ基、ノルマルプロ ピルチオ基、イソプロピルチオ基、ノルマルブチルチオ 基、ニトロ基、トリフルオロメチル基、ジメチルアミノ 基がより好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロ ピル基、ターシャリープチル基、シクロプロピル基、フ ニュニル基、メトキシ基、エトキシ基、フェニルオキシ 基、ベンジルオキシ基、メチルチオ基、ニトロ基、トリ フルオロメチル基、ジメチルアミノ基が特に好ましい。 【0025】 bとしては、0~1が好ましく、0がより 好ましい。

40 【0026】Cbとしては、一般式(1)で述べたのと 同様の基が好ましい範囲として選択される。

【0027】次に本発明の一般式 (III) の化合物について詳細に説明する。R、 $R^2$ 、a、nとしては、一般式 (I) で述べたのと同様の基がそれぞれ好ましい範囲として選択される。 $R^4$ としては、炭素数  $I\sim 9$  のアルキル基が好ましく、炭素数  $I\sim 6$  のアルキル基が特に好ましい。C b としては一般式 (I) で述べたのと同様の基が好ましい範囲として選択される。

50 【0028】次に本発明の一般式 (IV) の化合物につい

て詳細に説明する。R¹、R²、a、n、Cb、bとして は、一般式(11)で述べたのと同様の基がそれぞれ好ま しい範囲として選択される。Hetとしては、トリアゾ ール、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアジ ン、ピラジン、ピリミジン、フラン、ピロール、チオフ ェン、オキサゾール、ピリジン、ベンゾフラン、フェナ ンスロリン等の環が好ましく、トリアゾール、チアジア ゾール、オキサジアゾール、トリアジン、フラン、ピロ ール、チオフェン、オキサゾール、ピリジン、フェナン スロリン等がより好ましく、トリアゾール、オキサジア 10 物例を示す。 ゾール、トリアジン、ピロール、チオフェン、オキサゾ ール、ピリジン、フェナンスロリン等が特に好ましい。 またこれ等の環は置換基を有していても良く、置換基と\*

\*しては、アルキル基、アリール基、シアノ基が好まし く、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプ ロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、ターシャ リープチル基、フェニル基、シアノ基がより好ましく、 メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロピ ル基、ターシャリープチル基、フェニル基、シアノ基が 特に好ましい。

【0029】以下に本発明に用いられる一般式(1)~ (IV) で表される化合物のうち特に有効な代表的な化合

[0030]

【化9】

[0031]

【化10】

【0032】次に、上記の一般式(I)~(IV)で表さ れる重合体の製造方法について説明する。重合の方法 は、米国特許、第5,777,070号等に開示されて いる方法や、Macromolecules, 1997 年,30巻,7686-7691項等に記載されている 方法に従って行う事ができる。二官能の硼酸試薬と芳香 族ハロゲン化物のカップリング反応により重合を行う場 合、両モノマーの比率は、0.90:1.10~1.0 0:1.00が好ましく、0.95:1.05~1.0 40 ロゲン化物モノマーに対して、1~10当量が好まし 0:1.00がより好ましく、0.98:1.02~ 1.00:1.00が特に好ましい。使用する溶媒は、 各モノマーを少なくとも1%以上、好ましくは2%以上 溶解して溶液をなすものが好ましく、より好ましくは、 炭素数6~20までの芳香族基含有溶媒、特には、ベン ゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メシチレ ン、アニソール、またはこれらのフッ素化物が好ましい がトルエンが最も好適に使用される。使用する溶媒の量 は、重合の進行により増粘する反応混合物を効果的に攪 拌出来るように選択されるが、一般的にはモノマー1g 50 【0034】相関移動触媒の使用は、ポリマーの重合度

11

に対して $1\sim100$ mlが好ましく、 $3\sim50$ mlがよ り好ましく、5~20mlが特に好ましい。

【0033】使用する塩基としては、水溶性有機塩基が 好ましく、アルカリ金属炭酸塩、アルカリ金属炭酸水素 塩がより好ましく、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムが特 に好ましい。使用する塩基の水中の濃度としては、1~ 10規定が好ましく、1~5規定がより好ましく、1~ 3 規定が特に好ましい。使用する塩基の量としては、ハ く、1~5当量がより好ましく、1~3当量が特に好ま しい。使用する重合触媒としては、パラジウム触媒が好 ましく、Pd(II)塩またはゼロ価パラジウム(Pd (0)) がより好ましく、酢酸パラジウム、またはテト ラキス (トリフェニルフォスフィン) パラジウムが特に 好ましい。使用する重合触媒の量としては、モノマー1 モルに対して、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-1}$  モルが好まし く、 $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-2}$  モルがより好ましく、 $1 \times$ 10<sup>-4</sup>~5×10<sup>-3</sup>モルが特に好ましい。

を上げる為に、非常に効果的である。使用する相関移動 触媒としては、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、クラ ウンエーテル、クリプタン等が好ましく、テトラアルキ ルアンモニウムハライド、テトラアルキルアンモニウム 硫酸水素塩、テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド 等がより好ましく、テトラノルマルブチルアンモニウム ハライド、ベンジルトリエチルアンモニウムハライド、トリカプリルイルメチルアンモニウムクロライド等が特 に好ましい。使用する相関移動触媒の量としては、モノ マー1モルに対し0.01モル~1モルが好ましく、 0.01モル~0.5モルがより好ましく、0.05モ ル~0.3モルが特に好ましい。

【0035】重合反応の温度としては、使用する溶媒の 沸点付近が好ましいが、室温~170℃が好ましく、室 温~150℃がより好ましく、室温~130℃が特に好 ましい。重合時間としては、1~50時間が好ましく、 1~24時間がより好ましく、1~10時間が特に好ま しい。生成するポリマーの重合度としては、5~100 000が好ましく、10~10000がより好まし く、20~10000が特に好ましい。ポリマーの分 20 散度は1.0~10が好ましく、1.0~7.0がより 好ましく、1.0~5.0が特に好ましい。

【0036】重合させたポリマーの精製法も特には限定されないが、通常反応溶液を直接あるいは上記の重合に適した溶媒により希釈した後、貧溶媒に滴下して再沈殿精製する方法が好ましい。貧溶媒としては、アルコール、水、アセトン、酢酸エステル、アセトニトリル、炭化水素系溶媒およびこれらの混合溶媒が好ましく、エタノール、メタノール、水、アセトン、酢酸エチル、アセトニトリル、ヘキサン、ヘプタンおよびこれらの混合溶媒がより好ましく、エタノール、メタノール、水、アセトン、酢酸エチル、アセトニトリル、ヘキサンおよびこれらの混合溶媒がより好ましい。

【0037】次に、一般式(I)~(IV)で表される重 合体であることを特徴とする発光素子材料について説明 する。なお、本発明において発光素子材料とは、発光性 化合物単独の役割、又は電子注入性化合物、電子輸送性 化合物、ホール注入性化合物、ホール輸送性化合物、お よびホスト化合物といった複数の役割を担う材料を意味 する。重合体は単一の成分からなるホモポリマーであっ ても良いし、多成分からなる共重合体であっても良い。 また上述の様に、特定の可溶溶媒中でモノマーを重合さ せて得られたポリマーをそのまま、あるいは必要に応じ て精製したのちに使用しても良い。またキャリア移動性 の観点から一般式(I)~(IV)で表される重合体が電 子注入性化合物、電子輸送性化合物、ホール注入性化合 物、ホール輸送性化合物、ホスト化合物およびこれらの 複数の役割を担う事が好ましい。発光素子用材料または 半導体素子用材料としてのポリマーのキャリア移動性の 度合いも特には限定されないが、電界強度400~10 50 0.0 ((V/c m)  $^{1/2}$ ) の範囲で、電子移動度およびホール移動度ともに  $1.0\times10^{-8}$  c m $^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$ 以上の値が好ましく、 $1.0\times10^{-7}$  c m $^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$ 以上の値がより好ましく、 $1.0\times10^{-6}$  c m $^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$ 以上の値が特に好ましい。

【0038】次に、一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なくとも一層が一般式(I)~(IV)で表される重合体を含有する発光素子ついて説明する。発光素子用材料または半導体素子用材料としてのポリマーのキャリア移動性の度合いも特には限定されないが、電界強度400~1000((V/cm) $^{1/2}$ )の範囲で、電子移動度およびホール移動度ともに1.0×10 $^{-8}cm^2$ ・ $V^{-1}\cdot s^{-1}$ 以上の値が好ましく、1.0×10 $^{-6}cm^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$ 以上の値が特に好ましい。

【0039】本発明の発光素子は、陽極と陰極の一対の電極間に、発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した構成であり、発光層のほか保護層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いることができる。

【0040】有機化合物層は、電子注入性化合物、電子輸送性化合物、電子注入性および輸送性を兼ねる化合物(電子注入性兼輸送性化合物)、ホール注入性化合物、ホール輸送性化合物、ホール注入性兼輸送性化合物)、電子注入性兼輸送性とホール注入性兼輸送性のそれぞれを兼ねる化合物(電子注入性兼輸送性化合物兼ホール注入性兼輸送性化合物)、発光性化合物、ホスト化合物、電子供与性ドーバント、電子受容性ドーパント等から選択される幾つかの材料を含有して使用するものである。

【0041】本発明の有機化合物層は高分子化合物のみで構成されてもよいし、高分子化合物と低分子化合物の混合物で構成されていてもどちらでもよい。

【0042】本発明の発光素子に使用する有機化合物層中に含まれる、電子注入性化合物、電子輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物、ホール注入性兼輸送性化合物、ホール輸送性化合物、ホール注入性兼輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物、発光性化合物、ホスト化合物、電子供与性ドーパント、電子受容性ドーパントなどのこれらの化合物は、幾つかの機能を担う性質、部分が一つの分子中に含有されていてもよい。またそれぞれの機能が、別々の分子に分かれていてもよい。

【0043】電子注入性兼輸送性化合物兼ホール注入性 兼輸送性化合物が担う電子注入性および輸送性、ホール 注入性および輸送性の寄与の割合は化合物により異なる 値をとり得る。

【0044】本発明の有機化合物層の電子移動度は駆動

20

電圧の観点から、電界強度  $400 \sim 1000$  ((V/c m)  $^{1/2}$ ) の範囲で、 $3 \times 10^{-8}$  c m $^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$ 以上の値を有することが好ましく、 $1 \times 10^{-7}$  c m $^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$ 以上の値がより好ましく、 $5 \times 10^{-6}$  c m $^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$ 以上の値が更に好ましい。

【0045】有機化合物層の電子移動度は、電子注入性 化合物、電子輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合 物、ホール注入性化合物、ホール輸送性化合物、ホール 注入性兼輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物兼ホ ール注入性兼輸送性化合物の該層を構成するそれぞれの 化合物自身がもつ電子移動度により規定されるが、これ ら化合物同士の混合量によっても電子移動度が規定され る。該電子移動度の値を有する化合物としては、主にへ テロ原子含有有機化合物、電子輸送性有機化合物、有機 化合物錯体、有機金属錯体、有機金属化合物、電荷移動 錯体、およびこれらの重合体、共役系ポリマー、導電性 ポリマー等が知られているが、上記電子移動度の値を満 たすものであれば特に限定される事はなく、適宜選択し て使用できる。上記の例の中で、含窒素有機化合物、含 酸素有機化合物、含硫黄有機化合物、含硼素有機化合 物、含珪素有機化合物、含燐有機化合物、液晶性有機化 合物、結晶性有機化合物、有機化合物錯体、有機金属錯 体、有機金属化合物、電荷移動錯体、共役系ポリマー等 が好ましく、中でもヘテロ原子含有芳香族有機化合物、 ヘテロ原子含有芳香族有機化合物の電荷移動錯体、有機 金属化合物、電荷移動錯体、液晶性有機化合物、結晶性 有機化合物およびこれらの重合体、共役系ポリマー等が より好ましい。

【0046】本発明における電子移動度の測定は、タイム オブ フライト (以下、TOFと称する) 法により 測定した。TOF法については、シンセティック メタルズ (Synth. Met.) 111/112, (2000) 331ページの記載を 参照できる。

【0047】本発明の有機化合物層に用いられる化合物のイオン化ポテンシャルは、通常は最小値をもつ化合物により決まる。該化合物のイオン化ポテンシャルはホール注入性の観点で4.7eV以上10.0eV以下であることが好ましく、4.8eV以上10.0eV以下であることがより好ましく、4.9eV以上10.0eV以下であることが更に好ましい。本発明の有機化合物層は用いられるアリールアミン誘導体のイオン化ポテンシャルも同様にホール注入性の観点で5.0eV以上10.0eV以下であることが好ましく、5.1eV以上10.0eV以下であることが好ましく、5.2eV以上10.0eV以下であることが更に好ましい。

着プロセスでもよいし、塗布プロセスでもよい。塗布プロセスの場合、好ましい塗布溶媒としては水、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、蟻酸、酢酸、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロエタン、テトラヒドロフランおよびこれらの混合溶媒が好ましく、水、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、酢酸、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール、ジオキサン、トルエン、クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、テトラヒドロフランおよびこれらの混合溶媒がより好ましい。

16

【0049】陽極はホール注入性化合物、ホール輸送性 化合物、ホール注入性兼輸送性化合物、ホスト化合物な どにホールを供給するものであり、金属、合金、金属酸 化物、導電性化合物、またこれらの混合物などを用いる ことができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材料で ある。具体例としては、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イン ジウム、錫ドープ酸化インジウム (ITO) 等の導電性 金属酸化物、もしくは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、およびこれらの金属と導電性金属酸化物との混合 物、または無機導電性物質(積層物、沃化銅、硫化銅な ど)、有機導電性材料(ポリアニリン、ポリチオフェ ン、ポリピロールなど)、およびこれらとITOとの積 層物などが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物、 有機導電性材料、またはこれらの積層物であり、生産 性、高導電性、透明性等の点からITOまたはITO/ PEDOT-PSS積層物がより好ましい。陽極の膜厚 は材料により適宜選択可能であるが、通常10nm~5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは、50n  $m\sim 1 \mu m$ であり、更に好ましくは  $100 nm\sim 500$ n m である。

【0050】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用する事が好ましい。基板の厚みは、機械 的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガラ スを用いる場合には、通常O.2mm以上、好ましくは 0. 7 mm以上のものを用いる。陽極の作成には材料に よって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 合、電子ピーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、ITO分散物の 塗布などの方法で膜形成される。陽極は洗浄その他の処 理により、素子の駆動電圧を下げて発光効率を高めるこ とも可能である。例えばITOの場合、UV-オゾン処

【0051】陰極は電子注入性化合物、電子輸送性化合 物、電子注入性兼輸送性化合物、ホスト化合物などに電 子を供給するものであり、これらの化合物やマトリクス 化合物との密着性やイオン化ポテンシャル、安定性等を 考慮して選択される。陰極の材料としては金属、合金、 金属ハロゲン化物、金属酸化物、電気伝導性化合物、有 機金属塩またはこれらの混合物または積層物を用いるこ とができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばLi、 Na、K等)およびそのフッ化物または酸化物、アルカ リ土類金属(例えばMg、Ca等)およびそのフッ化物 10 たポリマー化合物など または酸化物、金、銀、鉛、アルニウム、ナトリウムー カリウム合金またはそれらの混合金属、リチウムーアル ミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウムー 銀合金またはそれらの混合金属、インジウム、イッテリ ビウム等の希土類金属、アルカリ金属およびアルカリ土 類金属の有機化合物塩等が挙げられ、好ましくは仕事関 数が4eV以下の材料であり、より好ましくはアルミニ ウム、リチウムーアルミニウム合金またはそれらの混合 金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの混合金属、 有機リチウム塩等である。

【0052】陰極は、上記化合物および混合物の単層構造だけでなく、上記化合物および混合物を含む積層構造を取ることもできる。陰極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常 $10nm\sim5\mu$ mの範囲が好ましく、より好ましくは $50nm\sim1\mu$ mであり、更に好ましくは $100nm\sim1\mu$ mである。陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時に蒸着することもできる。また複数の金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極および陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、 $15\Omega$ / $\Box$ 以下が好ましい。

【0053】発光性化合物は、電界印加時に陽極またはホール注入層、ホール輸送層からホールを注入することができると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を注入することができる機能や、注入された電荷を移動させる機能、ホールと電子の再結合の場を提供して発光させる機能を有するものであれば何でもよく、一重項励起子または三重項励起子のいずれから発光するものでもよい。発光性化合物として好ましくは共役系不飽和化合物またはオルトメタル化金属錯体またはボルフィリン金属錯体が挙げられるが、他の発光材料を併用して用いてもよい。発光材料は重合体を用いても低分子材料を用いてもよい。具体的には下記に挙げる化合物等を用いることができる。

【0054】(a) ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、スチリルベンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、ナフタルイミド、クマリン、ペリレン、ペリノン、

オキサジアゾール、アルダジン、シクロペンタジエン、 ピススチリルアントラセン、キナクリドン、ピロロピリ ジン、チアジアゾロピリジン、シクロペンタジエン、ス チリルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、ピレン、 およびこれらの誘導体など。

(b) 8 - キノリノールおよびその誘導体の金属錯体や希 土類錯体に代表される各種金属錯体など。

(c) ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリフェニレンビニレン、およびこれらの置換されたポリマー化合物など

(d) オルトメタル化金属錯体またはポルフィリン金属錯体など。

【0055】前記化合物の中でも、好ましく用いられる 化合物は以下のとおりである。スチリルベンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタ ジエン、クマリン、ペリレン、オキサジアゾール、ビス スチリルアントラセン、キナクリドン、シクロペンタジ エン、スチリルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、 ピレン、およびこれらの誘導体など;8ーキノリノール およびその誘導体の金属錯体や希土類錯体に代表される 各種金属錯体など;ポリチオフェン、ポリフェニレン、 ポリフルオレン、ポリフェニレンピニレン、およびこれ らの置換されたポリマー化合物など;オルトメタル化金 属錯体またはポルフィリン金属錯体など:

【0056】前記化合物の中でも、更に好ましく用いられる化合物は以下のとおりである。スチリルベンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、ペリレン、オキサジアゾール、ビススチリルアントラセン、スチリルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、ピレン、およびこれらの誘導体など;8ーキノリノールおよびその誘導体の金属錯体や希土類錯体に代表される各種金属錯体など;ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレン、ポリフェニレンとビニレンおよびこれらの置換されたポリマー化合物など;オルトメタル化金属錯体またはポルフィリン金属錯体など:

【0057】有機化合物層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常 $1 \text{ nm} \sim 5 \mu \text{ m}$ の範囲のものが好ましく、より好ましくは $5 \text{ nm} \sim 1 \mu \text{ m}$ であり、更に好ましくは $10 \text{ nm} \sim 500 \text{ nm}$ である。

【0058】有機化合物層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジェット法、印刷法、転写法、LB(ラングミュアーブロジェット)法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加熱蒸着、コーティング法、インクジェット法、印刷法である。コーティング法、インクジェット法、印刷法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することができ、樹50 脂成分としては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネ

ート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリプチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、ポリ(Nービニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0059】ホール注入性、ホール輸送性化合物は、陽 極からホールを注入する機能、ホールを輸送する機能、 陰極から注入された電子を障壁する機能のいずれか有し ているものであればよく、重合体を用いても低分子化合 物を用いてもよい。その具体例としては、カルバゾー ル、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 イミダゾール、ポリアリールアルカン、ピラゾリン、ピ ラゾロン、フェニレンジアミン、アリールアミン、アミ ノ置換カルコン、スチリルアントラセン、フルオレノ ン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザン、およびこれら の誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン 化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポルフィリン 系化合物、ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカル バゾール)誘導体、アニリン系共重合体、チオフェン化 合物、ポリチオフェン、置換および無置換ポリチオフェ ンーポリスチレンスルホン酸混合物等の導電性高分子オ リゴマー等が挙げられ、またこれらの混合物であっても よい。とりわけカルバゾール、トリアゾール、オキサゾ ール、オキサジアゾール、イミダゾール、フェニレンジ アミン、アリールアミン、フルオレノン、スチルペン、 シラザン、およびこれらの誘導体、芳香族第三級アミン 化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン 系化合物、アニリン系共重合体、チオフェン化合物、ポ リチオフェン、置換および無置換ポリチオフェンーポリ スチレンスルホン酸混合物等の導電性高分子オリゴマー 等がより好ましい。この中でも、ホール輸送機能の点で カルバゾール、トリアゾール、オキサゾール、オキサジ アゾール、イミダゾール、フェニレンジアミン、アリー ルアミン、フルオレノン、シラザン、およびこれらの誘 導体、芳香族第三級アミン化合物、チオフェン化合物、 置換および無置換ポリチオフェンーポリスチレンスルホ ン酸混合物等の導電性高分子オリゴマー等が更に好まし 40 い。

【0060】電子注入性化合物、電子輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物の材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から注入されたホールを障壁する機能のいずれか有しているものであればよい。具体例としては、ピリジン、ピラジン、キノリン、キノキサリン、フェナンスロリン、トリアジン、チエノピラジン、ベンズイミダゾール、ベンズオキサゾール、ベンゾトリアゾール、フェナントリジン、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、フルオレノ

ン、アントラキノジメタン、アントロン、ジフェニルキ ノン、チオピランジオキシド、カルビジイミド、フルオ ・レニリデンメタン、ジスチリルピラジン、フタロシアニ ン、およびこれらの誘導体、ナフタレンペリレン等の複 素環テトラカルボン酸無水物、8-キノリノール誘導体 の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾー ルやベンゾチアゾールを配位子とする各種金属錯体等が 挙げられる。混合物またはポリマーとして使用してもよ い。とりわけピリジン、ピラジン、キノリン、キノキサ リン、フェナンスロリン、トリアジン、フェナントリジ ン、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 フルオレノン、フタロシアニン、およびこれらの誘導 体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無 水物、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタ ロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを 配位子とする各種金属錯体等およびこれらのポリマーが より好ましい。この中でもピリジン、ピラジン、キノリ ン、キノキサリン、フェナンスロリン、トリアジン、ト リアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、フルオ レノン、フタロシアニン、およびこれらの誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン およびこれらのポリマーが更に好ましい。

【0061】本発明における有機化合物層に含有されるアリールアミンおよびその誘導体は、通常はホール注入性およびホール輸送性化合物、ホスト化合物として作用するが、高分子になると電子輸送性化合物としても作用することが知られている。アリールアミンおよびその誘導体は、具体的にはトリアリールアミンおよびその誘導体、Nーフェニルカルバゾールおよびその誘導体が好ましく、中でもNーフェニルカルバゾールおよびその誘導体がより好ましく用いられる。これらは低分子化合物であっても高分子化合物であってもよい。

【0062】保護層の材料としては、水分や酸素等の素 子劣化を促進するものが素子内へ侵入するのを防止する 機能を有しているものであればよい。その具体例として は、In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、T i、Ni等の金属、MgO、SiO、SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O 3、GeO、NiO、CaO、BaO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Y<sub>2</sub>O 3、TiO2等の金属酸化物、MgF2、LiF、Al F<sub>3</sub>、CaF<sub>2</sub> 等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリ プロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、 ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロ トリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレ ン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロ エチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少な くとも1種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重 合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有 する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、 吸水率 0. 1%以下の防湿性物質等が挙げられる。

50 【0063】保護層の形成方法についても特に限定はな

く、例えば化学蒸着法(CVD法)、真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシ(MBE)法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、インクジェット法、印刷法、コーティング法、転写法を適用できる。【0064】

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれにより限定されるものではない。 なお下記実施例において以下の測定を行った。重量平均 分子量は、ゲル濾過法を用いてテトラヒドロフランを溶 離液としてポリスチレン換算したものである。イオン化 ポテンシャルは紫外線光電子分析装置AC-1により測定 した。溶液の吸収は、クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mo 1/1の濃度のときのものである。エネルギーギャップ は、溶液吸収の長波端の波数をエネルギーに換算して求 めた。電子親和力はイオン化ポテンシャルの値からエネ ルギーギャップの値を差して求めた。膜の発光極大波長 は、ポリマー20mgをクロロホルム2mlに溶かした 20 溶液をガラス基板上に5000rpm×20秒の条件に てスピンコート塗布し、真空乾燥して得られた膜を、2 55nmの光で励起した時に測定したものである。ガラ ス転位温度はDSCを用いて通常の方法により測定した。 実施例 1 (例示化合物 1 の合成)

窒素気流下、2,7-ピス(4,4,5,5-テトラメ チルー 1, 3, 2-ジオキサボロランー <math>2-イル) - 9,9-ジーノルマルオクチルフルオレン1.6064g  $(2.50 \, \text{mmol}) \, , \, 1, \, 4 - \vec{y} \vec{y} \vec{u} + 2, \, 5 - \vec{y}$ メトキシベンゼン0. 7399g(2.50mmo 1)、トルエン11m1、トリカプリルイルメチルアン モニウムクロライド 0. I 2 5 g (0. 3 1 m m o l) を入れ室温で10分攪拌した。次いでテトラキス(トリ フェニルフォスフィン) パラジウム 0. 015g(0. 0125mmol: 0.25mol%) を加え、室温で1 0分攪拌した。次いで2M炭酸ナトリウム水溶液4.1 7mlを加え、緩やかに還流しながら二時間強く攪拌し た。次いでトルエン4.17mlを加え、還流しながら 更に15時間攪拌した。次いでトルエン5mlを加え還 流しながら更に9時間攪拌した。次いで、末端処理剤と して、2-フェニルー1,3,2-ジオキサポリナン 0. 1825g(1. 125mmol) を加え15時間 還流しながら攪拌し、次いでプロモベンゼン0.083 g (0.53mmol) を加え5時間還流しながら攪拌 した。反応終了後、トルエン20mlを加え希釈した 後、反応混合物を室温まで冷却し、メタノール:水=1 0:1(容積比)の溶液の中に攪拌しながら滴下し、再 沈殿精製した。得られたポリマーを濾過して集めた後、 メタノール、水で数回洗浄した。次いで室温で真空乾燥 して、例示化合物 1 のポリマーを得た。重量平均分子量 50 (Mw) 8000 (ポリスチレン換算)、数平均分子量 (Mn) 5000 (ポリスチレン換算)、イオン化ポテンシャル (IP) 5.85 eV、電子親和力2.81 eV、エネルギーギャップ3.04 eV、溶液の発光極大波長4 I 4 nm、吸収極大波長358 nm (クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長420 nm、膜の吸収極大波長365 nm、ガラス転位温度172℃。

【0065】実施例2(例示化合物2の合成)

実施例1の1, 4 - ジプロモー2, 5 - ジメトキシベンゼンを2, 6 - ジプロモピリジンに代えた以外は実施例1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物2の重合体を得た。重量平均分子量(Mw)34000、数平均分子量(Mn)14000、イオン化ポテンシャル(IP)5.90eV、電子親和力2.70eV、エネルギーギャップ3.20eV、溶液の発光極大波長383nm、吸収極大波長368nm、半値幅32nm(クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長408nm、吸収極大波長370nm、ガラス転位温度112℃。

【0066】実施例3(例示化合物3の合成)

実施例1の1,4ージプロモー2,5ージメトキシベンゼンを2,5ージプロモビリジンに代えた以外は実施例1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物3の重合体を得た。重量平均分子量(Mw)100000、数平均分子量(Mn)35000、イオン化ポテンシャル(IP)5.87eV、電子親和力2.99eV、エネルギーギャップ2.88eV、溶液の発光極大波長418nm、吸収極大波長386nm、半値幅40nm(クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長429nm、吸収極大波長388nm。

【0067】実施例4(例示化合物4の合成)

実施例1の1,4-ジプロモー2,5-ジメトキシベンゼンを1,4-ジプロモテトラフルオロベンゼンに代えた以外は実施例1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物4の重合体を得た。重量平均分子量(Mw)24000、数平均分子量(Mn)10000、イオン化ポテンシャル(IP)5.62eV、電子親和力2.40eV、エネルギーギャップ3.22eV、溶液の発光極大波長400nm、吸収極大波長341nm、半値幅63nm(クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長408nm、吸収極大波長347nm、ガラス転位温度58℃。

【0068】実施例5(例示化合物5の合成) 実施例1の1,4-ジブロモ-2,5-ジメトキシベンゼンを2,5-ビス(4-ブロモフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールに代えた以外は実施例1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物5の重合体を得た。 重量平均分子量(Mw)153000、数平均分子量(Mn)47000、イオン化ポテンシャル(IP)5. 23

86 e V、電子親和力 2.86 e V、エネルギーギャップ 3.00 e V、溶液の発光極大波長 4 l 0 n m、吸収極大波長 3 7 6 n m、(クロロホルム中、 l × l 0<sup>-7</sup>m o l / l)、膜の発光極大波長 4 4 6 n m、吸収極大波長 3 6 9 n m、ガラス転位温度 5 l ℃。

# 【0069】実施例6(例示化合物7の合成)

実施例 1 の 1 、 4 ージプロモー 2 、 5 ージメトキシベンゼンを 2 、 5 ージプロモピラジンに代えた以外は実施例 1 と同様にして重合、精製を行い、例示化合物 7 の重合体を得た。重量平均分子量(Mw) 2 5 0 0 0 、数平均 10分子量(Mn) 1 2 0 0 0 、イオン化ポテンシャル(IP) 5 、 9 2 e V、電子親和力 3 . 1 9 e V、エネルギーギャップ 2 . 7 3 e V、溶液の発光極大波長 4 4 3 nm、吸収極大波長 4 2 0 nm、(クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長 4 5 0 nm、吸収極大波長 4 2 8 nm、ガラス転位温度 7 5℃。

## 【0070】実施例7(例示化合物8の合成)

実施例1の1,4-ジプロモー2,5-ジメトキシベンゼンを1,3-ジプロモベンゼンに代えた以外は実施例1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物8の重合20体を得た。重量平均分子量(Mw)15000、数平均分子量(Mn)8000、イオン化ポテンシャル(IP)5.62eV、電子親和力2.26eV、エネルギーギャップ3.36eV、溶液の発光極大波長367nm、吸収極大波長343nm、(クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長418nm、吸収極大波長344nm、ガラス転位温度70℃。

# 【0071】実施例8

洗浄した I T O 基板上に、Baytron P (PED OT/PSS溶液 (ポリ (3, 4) エチレンジオキシチ 30 オフェンーポリスチレンスルホン酸ドープ体) /バイエル社製) を 1000 r p m、 30 秒でスピンコートした\*

試験化合物1.

\*後、150℃で1.5時間真空乾燥し、ホール注入/輸送性膜を作成した(膜厚約100nm)。この上に試験用化合物1:試験用化合物2:例示化合物5=8mg:30.4mg:1.6mgの混合物をキシレン4mlに溶かした溶液をスピンコート(1000rpm、20秒)した(膜厚約50nm)。次いでこの有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でカルシウムを膜厚250nmで蒸着した後、アルミニウムを膜厚300nmで蒸着し(1.0×10<sup>-3</sup>Pa~1.3×10<sup>-3</sup>Pa)、発光素子を作成した。

【0072】発光特性は以下のように測定した。東陽テ クニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、 ITOを陽極、カルシウム:アルミニウムを陰極として 直流定電圧を発光素子に印加し発光させ、輝度をトプコ ン社の輝度計BM-8、発光波長を浜松フォトニクス社 製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定し た。また、高温保存時の耐久性を評価するために、作製 した素子を60℃、20%相対湿度の条件下で3時間放 置後に発光させて相対輝度(駆動電圧10Vで、素子作 製直後の輝度を100とし、経時後輝度を相対値として 表示)を測定した。測定結果は以下のとおりである。最 低駆動電圧 (発光が観測される最低の電圧) は3 Vで、 10Vにおいて1145mA/cm<sup>2</sup>の電流密度を示 し、2290cd/m2の輝度で非常に色純度の良い濃 青色発光を示した。最大発光波長 lmaxは435 n m、半值幅 4 2 nm、色度座標 (0. 159, 0. 10 4)、外部量子効率 0. 21%であった。経時後の相対 輝度は85であった。

[0073]

-【化11】

試験化合物2.

# 【0074】実施例9

実施例8の例示化合物5を例示化合物4に代えた以外は 実施例8と同様にして素子を作成した。発光特性は実施 例8と同様に測定した。測定結果は以下のとおりであ る。最低駆動電圧(発光が観測される最低の電圧)は3 Vで、13Vにおいて1605mA/cm<sup>2</sup>の電流密度 を示し、1762cd/m<sup>2</sup>の輝度で非常に色純度の良 50 い濃青色発光を示した。最大発光波長  $\lambda$  max は 434 nm、半値幅49nm、色度座標(0.154,0.069)、外部量子効率0.19%であった。経時後の相対輝度は87であった。

#### 【0075】実施例10

実施例8の例示化合物5を例示化合物1に代えた以外は 実施例8と同様にして素子を作成した。発光特性は実施 例8と同様に測定した。測定結果は以下のとおりであ る。最低駆動電圧(発光が観測される最低の電圧)は3 Vで、11Vにおいて2085mA/cm²の電流密度 を示し、2560cd/m²の輝度で非常に色純度の良い濃青色発光を示した。最大発光波長λmaxは434 nm、半値幅43nm、色度座標(0.155,0.0 62)、外部量子効率0.33%であった。経時後の相 対輝度は89であった。

## 【0076】比較例1

実施例8の例示化合物5を公知化合物の試験化合物2に 代えた以外は実施例8と同様にして素子を作成した。発 光特性は実施例8と同様に測定した。測定結果は以下の とおりである。最低駆動電圧(発光が観測される最低の 電圧)は5 Vで、10 Vにおいて65 mA/c m²の電流密度を示したに過ぎず、97cd/m²の輝度を示したに過ぎなかった。また発光色は淡青~青緑色であった。極大発光波長 λ maxは422 n mと483 n m、半値幅125 n mの発光を示し、溶液での発光極大波長は約416 n m、半値幅は約40 n mであり)。色度座標は非常に色純度の低下した(0.178,0.264)を示した。外部量子効率は0.01%に過ぎなかった(10V、97cd/m²で測定)。経時後の相対輝度は65であった。

# [0077]

【発明の効果】上記の結果より、本発明の化合物を使用する事で、高輝度を示し、ポリマー主鎖間の相互作用によるエキサイマー形成を阻害して良好な色純度の素子を作成できることが明らかになった。更に高温保管後の輝度低下が小さく耐久性に優れた素子を提供できる。また塗布プロセスによる積層型素子の作成が実現でき、実用上有用である。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.